

Fachpraktikum Halbleiter-Technologie

SS / 2009

Ziel des Praktikums ist das Kennenlernen der Technik und der technologischen Prozessschritte für die Herstellung von SiGe-Heterobipolartransistoren (HBT's) durch praktische Laborarbeiten und die elektrische Charakterisierung der Transistoren.

Hierfür sind fünf Prozessschritte der modernen Mikroelektronik vorgesehen:

1. Schichtwachstum mit Molekularstrahlepitaxie
2. Metallisierungstechnik
3. Photolithographie
4. Elektrische Bauelement-Messtechnik
5. Aufbau- und Verbindungstechnik

Beginn: April/Mai 2009/ Ende: / Juli 2009 im Seminarraum 1.444 am ETI II

Die sieben Termine mit Einführung und Abschlusskolloquium sind in der Regel mittwochs bzw. donnerstags Nachmittag vorgesehen

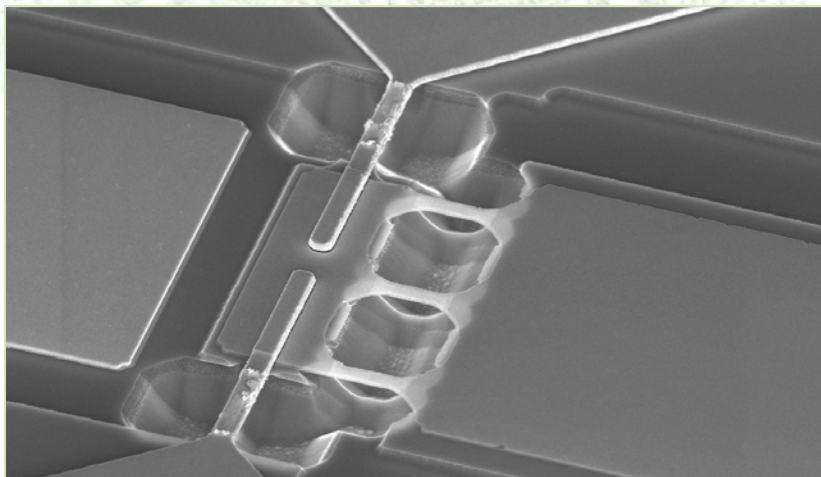
Anmeldung:

Interessenten die Halbleitertechnik 1^{*1} und Halbleitertechnologie^{*2} gehört haben

können sich vom 20. April bis zum 25. April 09 (erste Semesterwoche) am Institut für Halbleitertechnik bei:

Viktor Stefani, ETI II, EG. Raum 0.418

anmelden. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt.



¹ Pflicht

² Ist auch im parallel mit dem Praktikum möglich